

12423 907
23673
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. August 2005 (18.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/076363 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 29/12,
29/88, 29/772, 21/335, 33/00, H01S 5/34

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000080

(22) Internationales Anmeldedatum:
21. Januar 2005 (21.01.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 005 363.4 3. Februar 2004 (03.02.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH
[DE/DE]; Wilhelm-Johnen-Strasse, 52425 Jülich (DE).

(72) Erfinder; und

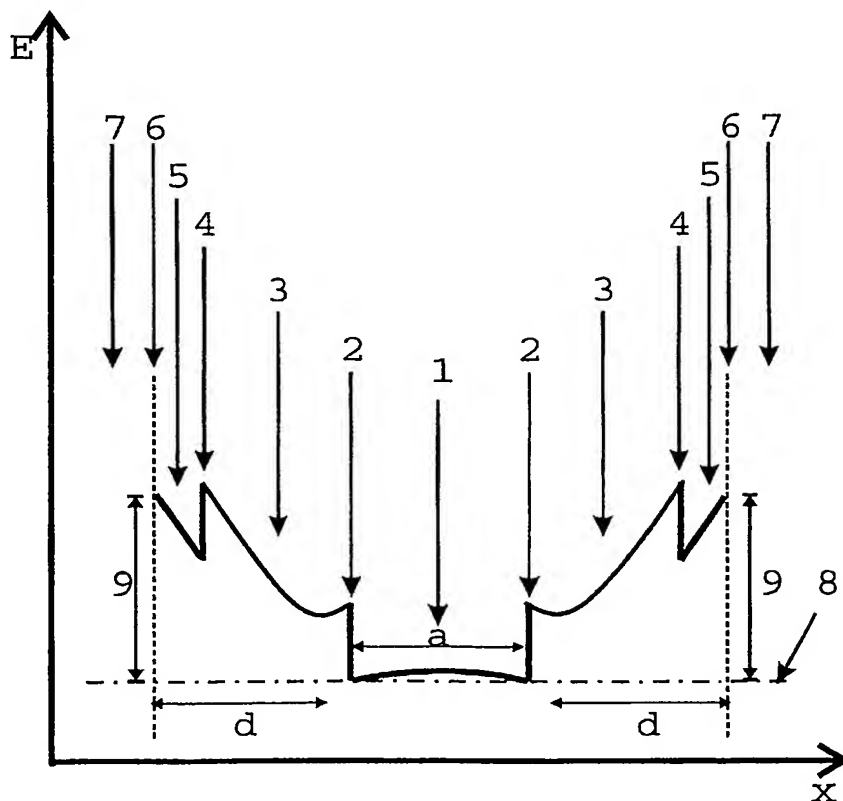
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): INDLEKOFER,
Michael [DE/DE]; Hermann-Sudermann-Str. 22, 52078
Aachen (DE). LÜTH, Hans [DE/DE]; Eupener Strasse
299 B, 52076 Aachen (DE). FÖRSTER, Arnold [DE/DE];
Breite Strasse 27, 52152 Simmerath (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: FORSCHUNGSZENTRUM
JÜLICH GMBH; Fachbereich Patente, Wilhelm-Johnen-
Strasse, 52425 Jülich (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SEMICONDUCTOR STRUCTURE

(54) Bezeichnung: HALBLEITER-STRUKTUR



(57) Abstract: The invention concerns a semiconductor structure comprising at least one first material region and a second material region, whereby the second material region epitaxially surrounds the first material region and forms a boundary surface. The structure is characterized in that Fermi level pinning is present on the non-epitaxial boundary surface of the second material region located opposite the boundary surface of both material regions, and the first material region forms a quantum well for free charge carriers. This advantageously results in enabling a controllable charge carrier concentration to be set in the quantum well.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Halbleiter-Struktur. Die Halbleiter-Struktur weist mindestens einen ersten Materialbereich und einen zweiten Materialbereich auf, wobei der zweite Materialbereich den ersten Materialbereich epitaktisch umschliesst und eine

Grenzfläche ausbildet. Die Struktur ist dadurch gekennzeichnet, dass Fermi-Level-Pinning an der, der Grenzfläche

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

beider Materialbereiche gegenüberliegenden, nicht epitaktischen Grenzfläche des zweiten Materialbereichs vorliegt und der erste Materialbereich einen Quantentopf für freie Ladungsträger ausbildet. Dadurch wird vorteilhaft bewirkt, dass eine steuerbare Ladungsträger-Konzentration im quantentopf eingestellt werden kann.